

BFG67; BFG67/XR

Кремниевый биполярный 8 ГГц широкополосный n-p-n транзистор.

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокий коэффициент усиления по мощности.
- Низкий коэффициент шума.
- Высокая частота перехода.
- Золотая металлизация обеспечивает отличную надежность..

ПРИМЕНЕНИЕ

 Широкополосные устройства в диапазоне ГГц, таких как спутниковые ТВ-тюнеры и портативные средства связи.

МАРКИРОВКА

Тип	Код
BFG67 (SOT143B)	V3%
BFG67/X (SOT143B)	%MV
BFG67/XR (SOT143R)	V26

РАСПИНОВКА

.	Обозначение		
Вывода	BFG67	BFG67/X	BFG67/XR
1	коллектор	коллектор	коллектор
2	база	эмиттер	эмиттер
3	змиттер	база	база
4	эмиттер	эмиттер	эмиттер





Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °C.

Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Uкб max	Напряжение <mark>колле</mark> ктор- <mark>база</mark>	20	В
Uкэ max	Напряжение ко <mark>ллект</mark> ор-эм <mark>иттер</mark>	10	В
U эб тах	Напряжение эмиттер-база	2.5	В
Iк max	Постоя <mark>нный ток</mark> ко <mark>ллекто</mark> ра	50	мА
Рк тах	Рассеиваемая мощность коллектора	380	мВт
Tj	Те <mark>мп</mark> ер <mark>ат</mark> ура <mark>пер</mark> ехода	175	°C
Tamb	Д <mark>иа</mark> пазон <mark>рабочих</mark> температур	-65 до 150	°C
Tstg	Д <mark>иапазон темпер</mark> атур хранения	-65 до 150	°C

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ при Токр. среды = 25 °C.

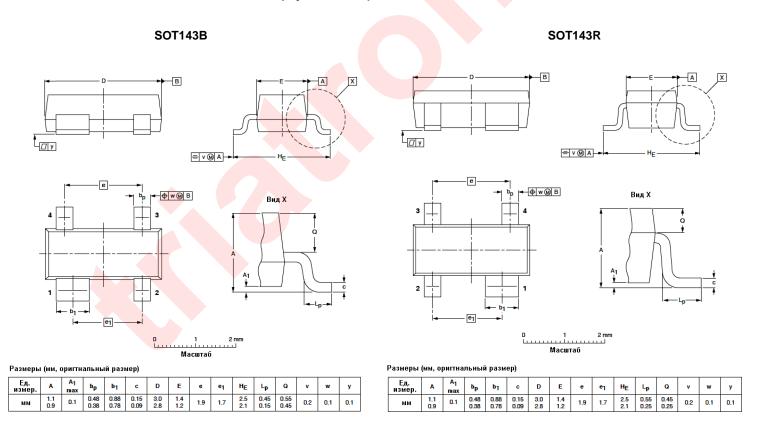
Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Rth j-a	Тепл <mark>овое соп</mark> ротивление от перехода к точке пайки	290	К/Ват

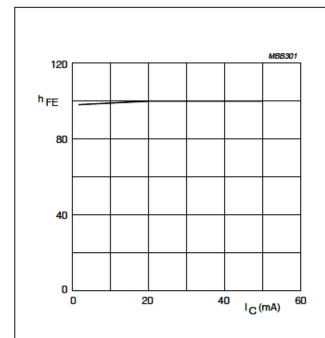


Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °C.

Обозначение	Параметр	Условия испытания	Мин.	Тип.	Макс	Единицы измерения
Ікбо	Коллектор-база ток отсечки	Uкб=5B, I _Э =0			50	нА
h ₂₁	Коэффициент передачи тока	I _к =15мА, Uкэ=5.0В	60	100		
frp.	Граничная частота коэф. передачи тока	I _к =15мА, Uкэ=8В, f=500МГц		8		ГГц
Ск	Емкость коллекторного перехода	Uкб=8B, I _Э =0, f=1мГц		0.7		пФ
Сэ	Емкость эмитерного перехода	Uэб=0.5В, I _К =0, f=1мГц		1.3		пФ
Coc	Емкость обратной связи	Uкб=8B, I _к =0, f=1МГц,		0.5		пФ
КуР	Коэффициент усиления по мощности	Uкэ=8B, I _к =15мА, f=1ГГц, Tamb=25°C Uкэ=8B, I _к =30мА, f=2ГГц, Tamb=25°C		17 10		дБ
Кш	Коэффициент шума	Uкэ=8B, I_K =5мA, f =1 Γ Γ μ , Tamb=25 $^{\circ}$ C Uкэ=8B, I_K =15мA, f =1 Γ Γ μ , Tamb=25 $^{\circ}$ C Uкэ=8B, I_K =5мA, f =2 Γ Γ μ , Tamb=25 $^{\circ}$ C Uкэ=8B, I_K =15мA, f =2 Γ Γ μ , Tamb=25 $^{\circ}$ C		1.3 1.7 2.5 3	<i></i>	дБ

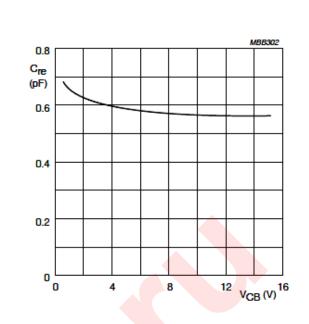
Пластиковый корпус для поверхностного монтажа, 4 вывода.





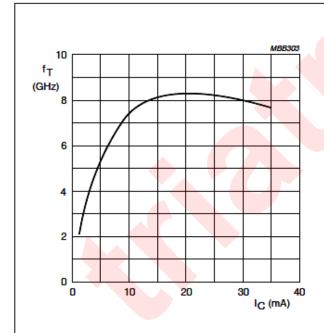
 $V_{CE} = 5 \text{ V}.$

DC current gain as a function of collector current.



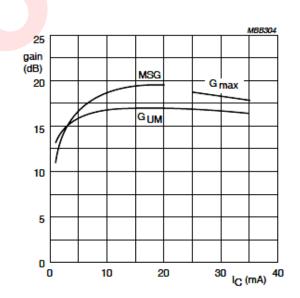
 $I_C = i_c = 0$; f = 1 MHz.

Feedback capacitance as a function of collector-base voltage.



 $V_{CE} = 8 \text{ V}$; $T_{amb} = 25 \degree$; f = 2 GHz.

Fig.6 Transition frequency as a function of collector current.

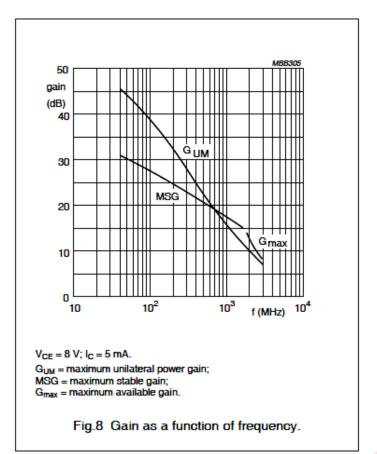


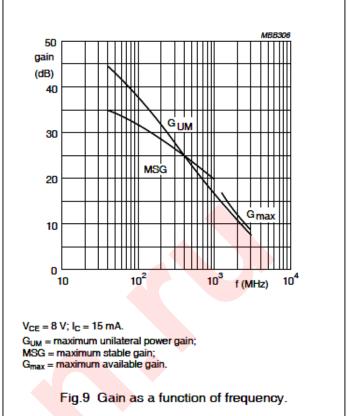
 $V_{CE} = 8 \text{ V}$; f = 1 GHz.

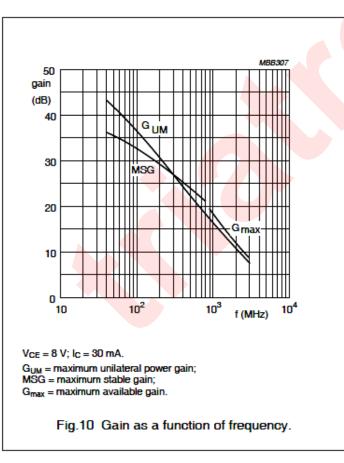
G_{UM} = maximum unilateral power gain; MSG = maximum stable gain;

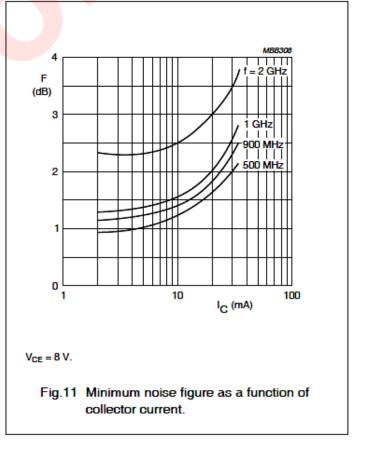
G_{max} = maximum available gain.

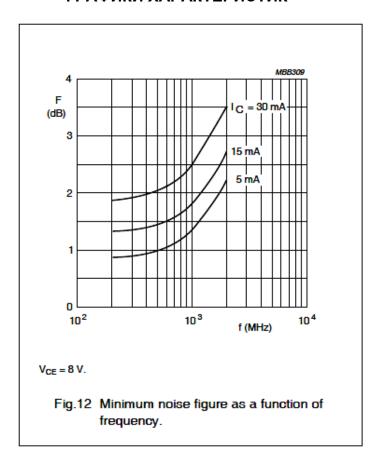
Fig.7 Gain as a function of collector current.









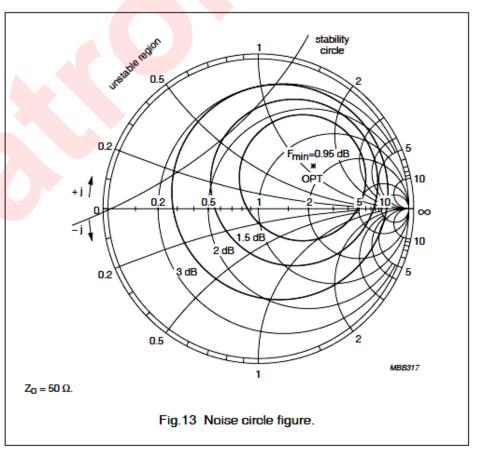


BFG67/X

f	V _{CE}	I _C
(MHz)	(V)	(mA)
500	8	5

Noise Parameters

Fmin	Gamma (opt)		D /50
(dB)	(mag)	(ang)	R _n /50
0.95	0.455	33.8	0.288

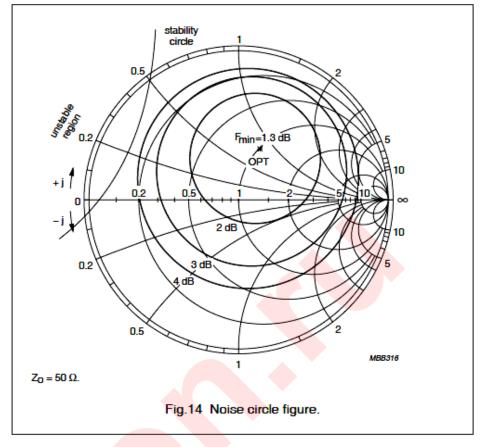


BFG67/X

f	V _{CE}	I _C
(MHz)	(V)	(mA)
1000	8	5

Noise Parameters

F _{min}	Gamma (opt) (mag) (ang)		D /50
(dB)			H _D /30
1.3	0.375	65.9	0.304



BFG67/X

f	V _{CE}	I _C
(MHz)	(V)	(mA)
2000	8	5

Noise Parameters

Fmin	Gamma (opt)		D /50	
(dB)	(mag)	(ang)	R _n /50	
2.2	0.391	136.5	0.184	

Average Gain Parameters

G _{MAX}	Gamma (max)	
(dB)	(mag)	(ang)
12	0.839	- 170

